

**Научная программа 48-й международной Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами**

*Секция 1  
Физика ориентационных эффектов*

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)	ФИО докладчика	Название доклада
<i>Устный доклад</i>	<i>А.Е. Иешкин, Д.С. Киреев, Ю.А. Ермаков, А.С. Трифонов, В.С. Черныш.</i>	<i>Распыление карбида кремния кластерными ионами аргона и ксенона</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>В.С. Малышевский, Г.В. Фомин, И.А. Иванова.</i>	<i>Можно ли измерить электромагнитное излучение внезапно стартующего заряда? Моделирование детектора зарядовых состояний релятивистских многозарядных ионов</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>Е.М.И. Elsehly, N.G. Chechenin, A.V. Makunin, H.A. Motaweh, A. A. Shemukhin, K.D. Kushkina.</i>	<i>Influence of ion beam irradiation on multiwalled carbon nanotubes struc- ture</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>А.В. Степанов.</i>	<i>Моделирование движения иона в углеродной нанотрубке с учетом влияния возмущения стенки и электронной подсистемы: расчет из первых принципов</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>О.О. Ивацук, А.А. Кленин, А.С. Кубанкин, М.В. Мишунин, А.Н. Олейник, А.С. Чепурнов, А.В. Щагин.</i>	<i>Углеродные нанотрубки в пироэлектрическом источнике рентгеновского излучения</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Н.В. Максютя, В.И. Высоцкий, Е.В. Мартыш, С.В. Ефименко, Д.Н. Максютя.</i>	<i>Ориентационное движение частиц в хиральных нанотрубках</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Ю.А. Белкова, Н.В. Новиков, Я.А. Теплова.</i>	<i>Установление равновесного зарядового распределения быстрых тяжелых ионов</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В.В. Сыщенко, Э.А. Ларикова.</i>	<i>Асимптотические формулы в теории дифракционного и переходного излучения на проводящей сфере</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В.В. Нецименко, М.М. Михайлов.</i>	<i>Влияние облучения протонами и электронами на оптические свойства оксидных нанопорошков</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В.И. Высоцкий, М.В. Высоцкий.</i>	<i>Эффект «коллективного каналирования» и оптимизация ускорительного ядерного синтеза в режиме дифракции Брэгга</i>

Стендовый доклад	<i>А.В. Бакаев, Д.А. Терентьев, Е.Е. Журкин.</i>	<i>Влияние сегрегации Ni и Cr вблизи дислокационных петель на их взаимодействие со скользящими дислокациями в облученных ОЦК-сплавах FeNiCr</i>
Стендовый доклад	<i>К.А. Вохмянина, В.С. Сотникова, А.А. Каплий, А. В. Сотников, О.О. Ивацук.</i>	<i>О возможности фокусировки пучков ускоренных электронов с помощью конусных капилляров.</i>
Стендовый доклад	<i>В.И. Высоцкий, А.А. Корнилова, Т.Б. Крит.</i>	<i>Исследование частотных, угловых и поляризационных характеристик неза-тухающих температурных волн</i>
Стендовый доклад	<i>Н.В. Максюта, В.И. Высоцкий, С.В. Ефименко.</i>	<i>Особенности осевого каналирования и квазихарактеристического излучения при каналировании релятивистских электронов в кристалле гидрида лития</i>
Стендовый доклад	<i>С.В. Трофименко, Р.М. Нажмудинов, Н.Ф. Шульга, А.С. Кубанкин, А.В. Шагин, Г.И. Бритвич, А.А. Дурум, М.Ю. Костин, В.А. Машигеев, Ю.А. Чесноков, А.А. Янович.</i>	<i>Ионизационные потери релятивистских частиц в кремниевом детекторе с плавно управляемой толщиной</i>
Стендовый доклад	<i>М.Н. Шипко, А.Л. Сибирев, Н.В. Усольцева, О.М. Масленникова, М.А. Степович, А.И. Смирнова.</i>	<i>Ориентационные эффекты, наблюдающиеся при прохождении электронов, индуцированных электрическим полем в водных растворах жидких кристаллов низкой концентрации</i>
Стендовый доклад	<i>А.А. Вирюс, М.Н. Шипко, М.А. Степович, В.В. Коровушкин, В.Г. Костишин, А.И. Тихонов.</i>	<i>Анализ состава и структуры оксидов Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, подвергнутых магнито-импульсной обработке</i>
Стендовый доклад	<i>Н.Н. Михеев, Н.А. Никифорова, М.А. Степович.</i>	<i>Идентификация диффузионной длины в нитриде галлия катодолуминесцентным методом в случаях экситонной рекомбинации и примесной рекомбинации неравновесных носителей заряда</i>
Стендовый доклад	<i>А.В. Антонов, В.И. Вдовин, В.А. Володин, В.П. Попов.</i>	<i>Формирование совершенных КНС структур переносом слоя кремния на сапфир при повышенных температурах</i>
Стендовый доклад	<i>В.П. Коцеев, Ю.Н. Штанов, Д.А. Моргунов, Т.А. Панина.</i>	<i>Моделирование процесса отклонения поляризованных электронов и позитронов с энергией 120 ГэВ изогнутым кристаллом кремния</i>
Стендовый доклад	<i>С.В. Трофименко, Н.Ф. Шульга.</i>	<i>Модифицированный эффект Чудакова в ионизационных потерях электрон-позитронных пар в тонких</i>

		<i>мишенях</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.С. Сабиров.</i>	<i>Исследование квантовых эффектов при каналах-лировании позитронов в нанотрубках методом численного решения уравнения Шредингера</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Г.М. Филиппов, В.А. Александров, И.В. Лысова, А.В. Степанов.</i>	<i>Прохождение волн и частиц через пористые структуры-I</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В.В. Амбарцумов, Н.П. Калашиников, А.С. Ольчак.</i>	<i>Вращение спина лептона в магнитном поле цепочки атомов</i>

## *Секция II*

### *Излучение электронов и позитронов в твёрдом теле*

<i>Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)</i>	<i>ФИО докладчика</i>	<i>Название доклада</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>О.В. Богданов, Ю.Л. Пивоваров, Т.А. Тухфатуллин.</i>	<i>Поляризационные характеристики излучения каналированных электронов в полуволновом кристалле</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>В. И. Алексеев, А.Н. Елисеев, П.Н. Жукова, Э. Ф. Иррибарра, В.А. Карпов, И.А. Кицин, А.С. Клюев, А.С. Ку-банкин, Р.М.</i>	<i>Нажмудинов Параметрическое рентгенов-ское излучение релятивистских электронов из мозаичных кристаллов</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>С.В. Блажевич, Р.А. Загороднюк, А.В. Носков.</i>	<i>Когерентное рентгеновское излучение, возбуждаемое пучком релятивистских электронов в периодической слоистой среде</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>А.В. Щагин.</i>	<i>Свойства переходного излучения, подвергшегося дифракции на кристалле</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>И.Е. Внуков, Ю.А. Гопонов, С.А. Лактионова, И.Р. Сиднина, М.А. Сиднин, Р.А. Шатохин</i>	<i>О невозмущающей диагностике электронных пучков высоких энергий с помощью периодических структур</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>О.О. Ивацук, А.В. Щагин, А.С. Кубанкин, И.С. Никулин, А.Н. Олейник.</i>	<i>Обнаружение рентгеновского излучения при сжатии пьезоэлектрика в вакууме</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>В.А. Андрианов, А.Л. Ерзинкян, Л.И.Ивлева, П.А. Лыков.</i>	<i>Рентгеновский пироэлектрический источник на основе кристалла Sr0.61Ba0.39Nb2O6</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>С.Р. Углов, А.В. Вуколов, В.В. Каплин, Л.Г. Сухих, П.В. Каратаев.</i>	<i>Излучение Черенкова в алюминии вблизи L – края поглощения</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>С.Ю. Гоголев, А.П. Потылицын.</i>	<i>Азимутальная асимметрия когерентного излучения Вавилова-</i>

		<i>Черенкова от наклонных электронных сгустков</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>О.О. Ивацук, В.Ю. Иониди, А.А. Кленин, А.С. Кубанкин, М.В. Мишунин, А.Н. Олейник, А.С. Чепурнов, А.В. Щагин.</i>	<i>Изучение свойств пироэлектрического генератора рентгеновского излучения</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>С.В. Блажевич, А.В. Носков, Д.О. Шкуронат.</i>	<i>Когерентное рентгеновское излучение, возбуждаемое пучком релятивистских электронов в монокристалле в направлении вперед</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В. И. Алексеев, А.Н. Елисеев, Э.Ф. Иррибарра, В.А. Карпов, И.А. Кицин, А.С. Ключев, А. С. Кубанкин, Р.М. Нажмудинов.</i>	<i>Влияние размеров зерен на выход параметрического рентгеновского излучения в поликристаллических средах</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.Н. Олейник, В.И. Волков, В.С. Мирошник, А.С. Кубанкин, А.В. Щагин.</i>	<i>Пироэлектрическая керамика в пироэлектрическом генераторе рентгеновского излучения</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>С.Р. Углов, А.В. Вуколов, Л.Г. Сухих.</i>	<i>Угловые распределения ВУФ излучения генерируемого электронами 5.7 МэВ в периодической структуре [Mo/Si] 50 зеркала</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>И.Е. Внуков, Ю.А. Гопонов, С.А. Лактионова, М.А. Сиднин, Р.А. Шатохин.</i>	<i>О механизме формирования дифрагированного переходного излучения быстрых электронов</i>

### *Секция III*

#### *Поверхность, рассеяние, распыление, эмиссия вторичных частиц и радиационные эффекты*

<i>Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)</i>	<i>ФИО докладчика</i>	<i>Название доклада</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>И.В.Пузынин, Т.П.Пузынина, З.К.Тухлиев, И.Г.Христов, З.А.Христова, З.А.Шарипов.</i>	<i>Развитие методов непрерывно-атомистического подхода для моделирования процессов взаимодействия тяжелых ионов высоких энергий с конденсированными средами</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>А.П.Зиновьев, П.Ю.Бабенко, Д.С.Мелузова, А.П.Шергин.</i>	<i>Определение потенциала взаимодействия налетающей атом-поверхности из данных о радужном рассеянии.  Аномальный коэффициент отражения ионов от кристалла в режиме поверхностного каналирования.</i>

Устный доклад	Ф.Ф.Умаров, А.А.Джурахалов.	Скользящее взаимодействие ион-поверхность твердого тела: ориентационные эффекты и возможности для анализа и модификации
Устный доклад	Е.В.Дуда, Г.В.Корнич.	Комбинирование методов гипердинамики и температурно-ускоренной динамики при моделировании атомных систем
Устный доклад	К.В. Карабешкин, А.И. Стручков, П.А. Карасёв, А.И. Титов M.W. Ullah, A. Kuronen, F. Djurabekova, K. Nordlund.	Влияние облучения атомарными и молекулярными ионами на свойства GaN
Устный доклад	В.В.Козловский, А.Э.Васильев, А.Н.Якименко, А.А.Лебедев.	Вторичное радиационное дефектообразование в Si и SiC при высокотемпературном протонном облучении
Устный доклад	Н.Н.Андреанова, Ф.М.Борисов, В.А.Казаков, Е.С.Машкова, М.А.Овчинников, Д.Н.Савушкина, Д.Н..Черненко, Н.Д.Черненко.	Ионно-лучевое гофрирование полиакрилонитрильного углеродного волокна
Устный доклад	Б.У.Умирзаков.	Применение ионной имплантации для получения наноразмерных структур на поверхности и приповерхностной области полупроводников
Устный доклад	Yu. Kudriavtsev, A. Hernandez, R. Asomoza.	Light emission from Si and Ge crystals after low energy and high dose Si <sup>+</sup> and Ge <sup>+</sup> ion implantation
Устный доклад	Д.А. Таимухамедова, А.К. Ташатов, Д.А. Нормуродов.	Создание ультратонких контактов на поверхности полупроводников
Устный доклад	А.П. Евсеев, А.А. Шемухин, М.Б. Гонгальский, Ю.В. Каргина, К.Д. Кушкина, В.С. Черныш.	Влияние дозы облучения на количество парамагнитных центров в пористом кремнии
Стендовый доклад	А.А. Ермоленко, Г.В. Корнич, С.Г. Буга.	Молекулярно-динамический анализ модификации нанокластеров металлов при бомбардировке низкоэнергетическими ионами на поверхности полиэтилена
Стендовый доклад	Д.В. Широкопад, Г.В. Корнич, С.Г. Буга.	Формирование оболочечных структур из двудольных биметаллических кластеров при бомбардировке частицами Ar и Ar <sup>13</sup>
Стендовый доклад	А.Н. Амрастанов, Е.В. Серегина, М.А. Степович, М.Н. Филиппов.	Оценка нагрева поверхности полупроводниковой мишени низкоэнергетичным электронным зондом

Стендовый доклад	<i>В.В. Калманович, Ю.А. Гладышев, М.А. Степович.</i>	<i>Об одном методе математического моделирования явлений теплопереноса, обусловленного воздействием широкого пучка киловольтных электронов на многослойную полупроводниковую структуру</i>
Стендовый доклад	<i>Д.В. Андреев, Г.Г. Бондаренко, В.В. Андреев, А.А. Столяров.</i>	<i>Зарядовые явления в МДП-структурах при радиационных облучениях и сильнополевой инжекции электронов</i>
Стендовый доклад	<i>Д.О. Савичкин, В.И. Кристя.</i>	<i>Моделирование методом Монте-Карло энергетических спектров ионов и атомов у поверхности электрода в тлеющем разряде в смеси аргона с парами ртути</i>
Стендовый доклад	<i>В.И. Кристя.</i>	<i>Расчет эмиссионной эффективности тонкой диэлектрической пленки на поверхности катода газоразрядного прибора</i>
Стендовый доклад	<i>Ю. Кудрявцев, О. Kudryavsteva, A. Escoboza, S. Nikishin.</i>	<i>Формирование упорядоченной структуры поверхности соединений <math>Al_xGa_{1-x}N</math> при распылении пучками ионов кислорода и цезия</i>
Стендовый доклад	<i>В.П. Афанасьев, А.С. Грязев, П.С. Капля.</i>	<i>Дифференциальные сечения неупругого рассеяния электронов в ниобии в диапазоне энергий 1-40 кэВ</i>
Стендовый доклад	<i>Е.Н. Воронина, Л.С. Новиков, Т.В. Рахимова.</i>	<i>Моделирование методом молекулярной динамики распыления наноразмерных стержней ионами низкой энергии</i>
Стендовый доклад	<i>Ю.А. Белкова, Я.А. Теплова.</i>	<i>Аналитический метод расчета пробегов легких ионов в углероде</i>
Стендовый доклад	<i>Д.А. Сафонов, А.С. Яшин, Н.В. Волков.</i>	<i>Распыление сплавов циркония ионами гелия и аргона с широким энергетическим спектром</i>
Стендовый доклад	<i>Д.А. Сафонов, Н.В. Волков, И.В. Олейников, Н.В. Сысоева, В.П. Самойлов.</i>	<i>Распыление монокристаллов кремния и стеклоуглерода под пучком ионов <math>He^+</math> и <math>Ar^+</math> с широким энергетическим спектром</i>
Стендовый доклад	<i>В.С. Бронский, С.Н. Шилюбреева.</i>	<i>Теоретическое моделирование распыления лунного реголита под воздействием ионов <math>H^+</math></i>
Стендовый доклад	<i>В.Н. Самойлов, А.И. Мусин.</i>	<i>Эволюция распределений распыленных атомов с изменением энергии связи при эмиссии с поверхности</i>

		<i>границы (001) Ni</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.И. Мусин, В.Н. Самойлов.</i>	<i>Механизмы фокусировки атомов, распыленных с поверхности монокристалла</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.А. Сычева, Е.Н. Воронина.</i>	<i>Использование различных потенциалов при МД моделировании распыления Si содержащих материалов</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А. И. Толмачев, Л. Форлано.</i>	<i>Расчет коэффициента самораспыления при бомбардировке твердого тела ионами: теория и компьютерное моделирование</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.В. Дубинко, Е.Е. Журкин, Д.А. Терентьев.</i>	<i>Микроструктура индуцированная воздействием высоко-поточной плазмы исследованная посредством трансмиссионной микроскопии</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.А. Абдувайитов, Х.Х. Болтаев, А.А. Узаков.</i>	<i>Состав и распределения примесных элементов по глубине системы Ni-CdS-SnO2</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Х.Х. Болтаев, Д.А. Ташмухамедова, З.Р. Саидахмедова.</i>	<i>Проявление квантоворазмерных эффектов в двухкомпонентных полупроводниковых наноструктурах</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>С.Б. Донаев, Б.Е. Умирзаков, М.К. Рузибаева.</i>	<i>Электронная структура наноразмерных структур Ga1-xAlxAs, созданных на поверхности GaAs методом ионной имплантации</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>С.Ж. Ниматов.</i>	<i>Структурные и электрофизические свойства тонких пленок, созданных на поверхности кремния</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Д.С. Руми, С.Ж. Ниматов, З.Р. Саидахмедова.</i>	<i>Исследование свойств поверхности монокристалла методами ДЭНЭ и ДЭСЭ при осаждении мономолекулярных пленок из ионных пучков</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Б.Е. Умирзаков, С.Ж. Ниматов.</i>	<i>Структура и свойства многослойных нанопленочных систем созданных на основе кремния</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>С.Е. Максимов, Н.Х. Джемилев, С.Ф. Коваленко, О.Ф. Тукфатуллин, Ш.Т. Хожиев.</i>	<i>ВИМС исследования энергии диссоциации кластеров VnOm- и NbnOm-, распыленных ионной бомбардировкой</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Д.А. Ташмухамедова, Ж.Ш. Содикжонов, Б. Ибрагимова, С.Т. Гулямова.</i>	<i>Электронная структура и эмиссионные свойства Ni, Mo и их</i>

		<i>окислов</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Б.Г. Атабаев, У.Б. Шаропов, Р. Джаббарганов, М.К. Курбанов. С.С. Курбанов.</i>	<i>Температурные зависимости распыления Si (111) при облучении ионами SF5</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Б.Г. Атабаев, У.Б. Шаропов, Р. Джаббарганов, М.К. Курбанов. С.С. Курбанов.</i>	<i>Температурные зависимости распыления поверхности Si (111) при облучении ионами Cs</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Б.Г. Атабаев, У.Б. Шаропов, Р. Джаббарганов, М.К. Курбанов. С.С. Курбанов.</i>	<i>Влияние низкоэнергетических электронов на поверхность кристаллов оксида цинка</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В.Г. Стельмах.</i>	<i>Осаждение атомарного углерода, метина и метилена на графен</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>И.Д. Ядгаров, В.Г. Стельмах, А.А. Джурахалов.</i>	<i>Влияние дефектов графена на минимальную энергию для его распыления</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.С. Сабиров.</i>	<i>Влияние поляризационных полей на каналирование легких ионов в углеродных нанотрубках</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.Н. Пустовит.</i>	<i>Эмиссионная теория распыления аморфных материалов. Зависимость коэффициента распыления от угла падения первичных ионов</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>А.Н. Пустовит.</i>	<i>Эмиссионная теория распыления аморфных материалов. Самораспыление</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Е.А. Лигачева, О.А. Буреев, М.В. Жидков, Э.Ш. Имамединов, Ю.Р. Колобов, А.Е. Лигачев, Г.В. Потемкин, В.Ю. Степаненко.</i>	<i>Влияние ионной обработки на смачивание поверхности графита</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>О.А. Буреев, М. В. Жидков, Ю.Р. Колобов, Е.А. Лигачева, А.Е. Лигачев, Г.В. Потемкин, Э.Ш. Имамединов.</i>	<i>Воздействие на поверхность пирографита плазмой аргона</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>О. К. Lepakova, G.V. Potemkin, N.N. Golobkov, M.V. Zhidkov, Yu.R. Kolobov, A.E. Ligachev, Y.M. Maksimov, N.N. Koval, A.D. Teresov.</i>	<i>Investigation of SHS-process in the mixture of powders of TI, AL, C, initiated by pulsed electron beam</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>О.А. Подсвилов, А.И. Немцев, А.И. Сидоров, У.В. Юрина.</i>	<i>Формирование металлических наночастиц в целочно-галлоидных кристаллах при электронном облучении</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>П.А. Карасёв, К.В. Карабешкин, М.А. Шевцов, А.И. Титов.</i>	<i>Накопление нарушений структуры в Si при последовательной имплантации различных типов ионов</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>И.Г. Дьяков, В.С. Севостьянова.</i>	<i>Диффузия азота и углерода в</i>



		<i>поверхность стали 20 при электролитно-плазменной обработке в растворе с нитратом аммония и глицерином</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>В.И. Шульга.</i>	<i>Влияние поверхностного рельефа на распыление аморфного углерода</i>

#### *Секция IV*

#### *Модификация и анализ поверхности*

<i>Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)</i>	<i>ФИО докладчика</i>	<i>Название доклада</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>В.Б. Выходец, Т.Е. Куренных, О.А. Нефедова, Е.В. Выходец, С.И. Обухов.</i>	<i>Исследование температурной зависимости коэффициентов диффузии дейтерия в никеле с помощью ядерного микроанализа в режиме «он-лайн».</i>  <i>Исследование с помощью ядерного микроанализа растворимости дейтерия в оксидных нанопорошках.</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>И.И. Ташлыкова-Бушкевич, Ю.С. Яковенко, И.А. Бушкевич, О.Г. Бобрович, В.Г. Шепелевич.</i>	<i>Композиционный состав и характер смачивания сплавов Al-Cr, полученных высоко- и гиперскоростной кристаллизацией</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>В.К. Егоров, Е.В. Егоров, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов.</i>	<i>Изучение эпитаксиальной структуры SiC/C ионно-пучковыми и рентгеновскими методами</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>И.Е. Тысченко, М. Voelskow, А.Н. Михайлов, Д.И. Тетельбаум.</i>	<i>Пространственное распределение индия и мышьяка в пленках SiO<sub>2</sub> в условиях ионно-лучевого синтеза соединения InAs</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>В.В. Привезенцев, В.С. Куликаускас, В.А. Скуратов, К.Д. Щербачев, Э.А. Штейнман, А.Н. Терещенко, Н.Н. Колесников, А.Н. Палагушкин.</i>	<i>Ионно-имплантационное формирование и ионно-трековая модификация наночастиц ZnO в кварце</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>Л.Е. Агуреев, К.А. Аникин, А.М. Борисов, А.В. Виноградов, В.Г. Востриков, С.В. Савушкина, Н.В. Ткаченко, А.В. Эпельфельд.</i>	<i>Исследование керамикоподобных покрытий на алюминиевых композитах с использованием спектрометрии ядерного обратного рассеяния</i>
<i>Устный доклад</i>	<i>Балакиин Ю.В., Шемухин А.А., Назаров А.В., Черныш В.С., Кожемяко А.В.</i>	<i>Влияние процессов каналирования и дефектообразования на профиль распределения ксенона при имплантации в монокристалл кремния</i>

Стендовый доклад	Поплавский В.В., Дорожко А.В., Матыс В.Г.	Исследование состава и свойств каталитических слоев, формируемых ионно-ассистируемым осаждением олова и платины на углеродные носители
Стендовый доклад	Поплавский В.В., Дорожко А.В., Матыс В.Г.	Исследование состава и свойств защитных слоев, формируемых на поверхностях сталей ионно-ассистируемым осаждением ванадия и алюминия
Стендовый доклад	Окулич Е.В., Белов А.И., Королев Д.С., Окулич В.И., Гориков О.Н., Михайлов А.Н., Тетельбаум Д.И.	Влияние ионного облучения на электрофизические параметры мемристорных структур
Стендовый доклад	Вершинин Г.А., Панова Т.В.	Роль неизотермического локально неравновесного массопереноса в формировании элементного состава при высокоскоростном затвердевании бинарных расплавов
Стендовый доклад	Ковивчак В.С., Панова Т.В., Калинина Я.А.	Влияние морфологии поверхности титановых имплантатов, облученных мощным ионным пучком, на кристаллизацию гидроксилатапата
Стендовый доклад	Борисовский П.А., Гаврилов С.В., Моос Е.Н., Киселев Г.В., Киселева Л.И.	Изучение морфологии поверхности катода He-Ne лазера в процессе воздействия ионных пучков
Стендовый доклад	Исаханов З.А., Умирзаков Б.Е., Мухтаров З.Э., Курбанов Р.	Изменение состава, структуры и физические свойства ионно-легированных образцов W и WO <sub>2</sub> после технологических обработок
Стендовый доклад	Ниматов С.Ж., Руми Д.С.	Исследование механизмов аморфизации-рекристаллизации поверхности Si(111) при низкоэнергетическом облучении ионами щелочных металлов
Стендовый доклад	Ниматов С.Ж., Руми Д.С., Саидахмедова З.	Исследование электронно-стимулированных процессов при адсорбции кислорода на упорядоченных и дефектных поверхностях (111) и (100) кремния
Стендовый доклад	Умирзаков Б.Е., Ниматов С.Ж.	Получение и изучение свойств нанопленочных структур на основе кремния методом низкоэнергетической ионной имплантации и отжига
Стендовый доклад	Умирзаков Б.Е., Донаев С.Б., Болтаев Х.Х., Рузиева Л.Х.	Влияние ионной бомбардировки на эмиссионные и оптические свойства

		<i>GaAs</i>
Стендовый доклад	<i>Арустамов В.Н., Аиуров Х.Б., Худойкулов И.Х., Кахрамонов Б.</i>	<i>Характерные масштабы областей ионизации и катодного падения дугового разряда в вакууме</i>
Стендовый доклад	<i>Арустамов В.Н., Аиуров Х.Б., Худойкулов И.Х., Кахрамонов Б.</i>	<i>Влияние вакуумно-дуговой обработки стальной поверхности на коррозионную устойчивость окрашенных сталей</i>
Стендовый доклад	<i>Арустамов В.Н., Аиуров Х.Б., Худойкулов И.Х., Кахрамонов Б.</i>	<i>О тепловом воздействии вакуумной дуги при обработке стальной поверхности</i>
Стендовый доклад	<i>Шаропов У.Б., Атабаев Б.Г., Джаббарганов Р., Курба-нов М.К., Шарипов М.М.</i>	<i>Зарядка поверхности оксидов при облучении электронными пучками низких энергий</i>
Стендовый доклад	<i>Юсунджанова М.Б., Таимухамедова Д.А., Саидахмедова З., Гулямова С.Т.</i>	<i>Электронная структура нанопленочной структуры Si – SiO<sub>2</sub> – Si, Si – CoSi<sub>2</sub> – Si</i>
Стендовый доклад	<i>Умирзаков Б.Е., Таимухамедова Д.А., Эргашов Ё.С., Ибрагимова Б.В.</i>	<i>Получение наноразмерных фаз Co Si<sub>2</sub> на поверхности и приповерхностной области Si</i>
Стендовый доклад	<i>Таимухамедова Д.А.</i>	<i>Профили распределения атомов по глубине ионно-имплантированных диэлектрических пленок</i>
Стендовый доклад	<i>Умирзаков Б.Е.</i>	<i>Электронная структура тонких пленок CoSi<sub>2</sub>/Si полученных методами эпитаксии и ионной имплантации</i>
Стендовый доклад	<i>Рысбаев А.С., Хужаниязов Ж.Б., Бекпулатов И.Р., Файзуллаев Р.Ф.</i>	<i>Исследование процессов формирования наноразмерных плёнок силицидов при имплантации низкоэнергетических ионов в Si (111)</i>
Стендовый доклад	<i>Рысбаев А.С., Бекпулатов И.Р., Рысбаева З.А., Рахимов А.М.</i>	<i>Об электропроводности систем «наноплёнка силицида - Si», полученных высокодозной имплантацией низкоэнергетических ионов некоторых элементов</i>
Стендовый доклад	<i>Кабышев А.В., Конусов Ф.В.</i>	<i>Эволюция дефектного состояния облученного ионами хрома оксида алюминия после отжига в кислородосодержащей среде</i>
Стендовый доклад	<i>Соболева Э.Г., Литвиненко В.В.</i>	<i>Образование и отжиг радиационных дефектов в области пространственного заряда соединений Ga As и In P</i>

Стендовый доклад	Крючков Ю.Ю., Кудияров В.Н., Сыртанов М.С., Чернов И.П.	Влияние водорода на физические свойства никеля
Устный доклад	Шемухин А.А., Муратова Е.Н.	Исследование мембран нанопористого оксида алюминия методом резерфордовского обратного рассеяния
Устный доклад	Чернов И.П., Березнеева Е.В., Белоглазова П.А., Лидер А.М., Пушилина Н.С.	Взаимодействие водорода с защитными покрытиями циркониевых и титановых сплавов
Устный доклад	Сутыгина А.Н., Кашкаров Е.Б., Никитенков Н.Н., Прямушко Т.С., Волески Л.	Плазменно-иммерсионная имплантация титана в сплав циркония Э-110
Устный доклад	Король В.М., Заставной А.В.	Низкотемпературный оксидационный отжиг в легированном ионами натрия кремнии
Стендовый доклад	Бабаев А.А., Гоголев А.С.	Нагрев тонкой кристаллической мишени при прохождении коротких банчей электронов высокой энергии
Стендовый доклад	Святкин Л.А., Коротеев Ю.М., Чернов И.П.	Особенности взаимодействия водорода с гелием в цирконии. Расчёты из первых принципов
Стендовый доклад	Святкин Л.А., Коротеев Ю.М., Чернов И.П., Фомин М.Г.	Атомная и электронная структура Ti и Zr в присутствии водорода и вакансий. Расчёты из первых принципов
Стендовый доклад	Чернов И.П., Силкин В.М., Тюрин Ю.И.	Плазмонный механизм ускорения водорода в металлах в процессе воздействия излучения
Стендовый доклад	Борисов А.М., Востриков В.Г., Каменских А.И., Ткаченко Н.В.	Спектрометрия ядерного обратного рассеяния дисперсных материалов
Стендовый доклад	Дмитриевский А.А., Ефремова Н.Ю., Гусева Д.Г., Коренков В.В., Жигачев А.О.	Бета-индуцированное уменьшение объема металлизированной фазы кремния, формируемой при сосредоточенных нагрузках
Стендовый доклад	Углов В.В., Шиманский В.И., Ремнев Г.Е., Лебединский А.М., Смолянский Е.А., Лаук А.Л., Легостаев В.Н., Musil J.	Радиационная и термическая стабильность структурно-фазового состояния покрытий на основе системы Al-Si-N
Стендовый доклад	Углов В.В., Ремнев Г.Е., Сафронов И.В., Квасов Н.Т., Дорожкин Н.Н., Шиманский В.И.	Моделирование исходной дефектной структуры и полей напряжений в нанокompозите nc-TiN/a-Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
Стендовый доклад	Буреев О.А., Жидков М.В., Колобов Ю.Р., Лигачева Е.А., Лигачев А.Е., Потемкин	Модификация поверхности пирографита атмосферной плазмой

	<i>Г.В., Имамединов Э.</i>	
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Буреев О.А., Жидков М.В., Колобов Ю.Р., Серов М.М., Лигачев А.Е., Потемкин Г.В.</i>	<i>Обработка поверхности титана плазмой</i>
<i>Стендовый доклад</i>	<i>Новиков Л.С., Воронина Е.Н., Жияяков Л.А., Черник В.Н., Чирская Н.П.</i>	<i>Исследование полиимидных пленок после совместного облучения протонами низкой энергии и кислородной плазмой</i>